a) Para que el transistor opere en saturación, debe haber canal y se tiene que cumplin la condición Vos-Vos V+

En saturación, la relación entre Ips y Vos viene dada por

Como hay canal Vas > V+ así que despejamos Vas

$$(V_{GS} - V_{+})^{2} = \overline{I}_{DS} 2 \Leftrightarrow V_{GS} = V_{+} + |\overline{ZI_{DS}}| = V_{+} + |\overline{ZI_{DS}}|$$

$$V_{GS} = 2,3V + \sqrt{\frac{2 \cdot 0,2mA}{20 \cdot 550 \frac{cm^2}{V_5} \cdot 2,30 \cdot 10^{-7} \frac{F}{cm^2}}} = 2,7V$$

b) Para que el transistor opere en saturación, se tiene que verificar la condición Vos > V+ (que haya canal) y que Vos-Vos < VT

Para los dalos de a) VDS > 2,7V-2,3V = 0,4V

c) Si Vos = 20m V => estavemos en la zona lineal si Ves - 20m V > 2,3V => Vos > 2,32 V

Ahona IDS = K (VGS - VIN) VDS = 20.550 cm² 2,3.10 F (VGS - 2,3V).20mV = VGS · 5,06.10 - 1,1638.104 (Apreximación lineal)

$$I_{DS} = k \left(\left(V_{GS} - V_{th} \right) V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right) = V_{6S} \cdot S_{,06\cdot10^{-5}} - 1_{,1638\cdot10^{-4}} - k \frac{V_{DS}^2}{2} = V_{6S} \cdot S_{,06\cdot10^{-5}} - 1_{,16886\cdot10^{-4}}$$